

2018年秋季講演会 プログラム編集委員リスト

表1. 常設分科			
大分類分科名	中分類分科名	委員(所属)	
		下線は大分類分科代表又は合同セッション代表	
1 応用物理学一般	1.1 応用物理一般・学際領域	面谷信(東海大)	
	1.2 教育	吉田雅昭(八戸高専), 佐藤杉弥(日本工大)	
	1.3 新技術・複合新領域	松谷晃宏(東工大)	
	1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	小栗和也(東海大)	
	1.5 計測技術・計測標準	寺崎正(産総研)	
	1.6 超音波	近藤淳(静岡大)	
2 放射線	2.1 放射線物理一般・検出器基礎		
	2.2 検出器開発	越水正典(東北大), 人見啓太郎(東北大), 渡辺賢一(名大)	
	2.3 放射線応用・発生装置・新技術		
3 光・フォトンクス	3.1 光学基礎・光学新領域	小野篤史(静岡大)	
	3.2 材料・機器光学	石飛秀和(阪大), 三宮俊(リコー), 片山龍一(福岡工大)	
	3.3 情報フォトンクス・画像工学	片山龍一(福岡工大), 成瀬誠(情通機構), 山本裕紹(宇都宮大), 小倉裕介(阪大)	
	3.4 生体・医用光学	西館泉(農工大)	
	3.5 レーザー装置・材料	安原亮(核融合研), 宮本克彦(千葉大)	
	3.6 超高速・高強度レーザー	田邊孝純(慶応大), 高橋栄治(理研)	
	3.7 レーザープロセス	坂倉政明(サウサンプトン大), 佐藤正健(産総研)	
	3.8 光計測技術・機器	大久保章(産総研), 西山道子(創価大), 染川智弘(レーザー総研)	
	3.9 テラヘルツ全般	松原英一(大阪歯科大), 坪内雅明(量子研), 諸橋功(情通機構)	
	3.10 光子物理・技術	辻野賢治(東京女子医大)	
	3.11 フォトニック構造・現象	新家昭彦(NTT), 浅野卓(京大)	
	3.12 ナノ領域光学・近接場光学	酒井優(山梨大), 久保若奈(農工大)	
	3.13 半導体光デバイス	宮本智之(東工大), 荒川太郎(横国大), 佐藤具就(NTT)	
	3.14 光制御デバイス・光ファイバー	松下智紀(東大), 渡邊俊夫(鹿児島大), 和田篤(防衛大)	
	3.15 シリコンフォトンクス	庄司雄哉(東工大), 岡野誠(産総研)	
4 JSAP-OSA Joint Symposia すべてEnglish Session	4.1 Plasmonics and Nanophotonics	Prabhat Verma (Osaka Univ.), Takuo Tanaka (RIKEN), Nicholas Smith (Osaka Univ.)	
	4.2 pto-electronics, Silicon Photonics and Photonics Devices	Satoshi Iwamoto (Univ. of Tokyo), Nobuhiko Nishiyama(Titech)	
	4.3 Ultrafast Optics and Photonics	Kaoru Minoshima (The Univ. of Electro-Communications), Norihiko Nishizawa (Nagoya Univ.)	
	4.4 Information Photonics	Ryoichi Horisaki (Osaka Univ.), Hirotsugu Yamamoto (Utsunomiya)	
	4.5 Nanocarbon and 2D Materials	Yuhei Miyauchi (Kyoto Univ.)	
	4.6 Terahertz Photonics	Toshihiko Kiwa (Okayama Univ.)	
	4.7 Laser Material Processing and Manipulation	Masaaki Sakakura (University of Southampton), Mitsuhiro Terakawa (Keio Univ.)	
	4.8 Quantum Optics and Nonlinear Optics	Takashige Omatsu (Chiba Univ.), Takuya Hirano (Gakushuin Univ.)	
6 薄膜・表面	6.1 強誘電体薄膜	恵下隆(和歌山大), 山田智明(名大), 中嶋宇史(東理大)	
	6.2 カーボン系薄膜	赤坂大樹(東工大), 加藤由光(産総研)	
	6.3 酸化物エレクトロニクス	高橋竜太(東大), 木下健太郎(東理大)	
	6.4 薄膜新材料	西川博昭(近畿大), 土屋哲男(産総研)	
	6.5 表面物理・真空	小川修一(東北大), 服部梓(阪大)	
	6.6 プローブ顕微鏡	一井崇(京大), 杉本宜昭(東大)	
7 ビーム応用	7.1 X線技術	豊田光紀(東京工芸大)	
	7.2 電子ビーム応用	橘田晃宜(産総研), 根尾陽一郎(静岡大)	
	7.3 微細パターン・微細構造形成技術	山本治朗(日立), 谷口淳(東理大)	
	7.4 量子ビーム界面構造計測	香野淳(福岡大), 鈴木秀士(名大), 和達大樹(東大)	
	7.5 イオンビーム一般	龍頭啓充(東芝エネルギーシステムズ), 豊田紀章(兵庫県立大)	
	7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術	田川雅人(神戸大), 吉越章隆(原子力機構)	
8 プラズマエレクトロニクス	8.1 プラズマ生成・診断	富田健太郎(九大)	
	8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	竹中弘祐(阪大), 大村光広(東芝メモリ)	
	8.3 プラズマナノテクノロジー	古閑一憲(九大)	
	8.4 プラズマライフサイエンス	神野雅文(愛媛大)	
	8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	白井直機(北大)	
	8.6 Plasma Electronics English Session	酒井道(滋賀県立大)	
9 応用物性	9.1 誘電材料・誘電体	森本貴明(防衛大)	
	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	加納伸也(神戸大), 長島一樹(九大)	
	9.3 ナノエレクトロニクス	西口克彦(NTT物性研)	
	9.4 熱電変換	山田高広(東北大), 小菅厚子(大阪府立大)	
	9.5 新機能材料・新物性	高瀬浩一(日大), 笹川崇男(東工大)	
10 スピントロニクス・マグネティクス	10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	柳原英人(筑波大), 井口智明(東芝)	
	10.2 スピン基盤技術・萌芽のデバイス技術	野崎隆行(産総研)	
	10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	三輪真嗣(東大)	
	10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関	ファミナムハイ(東工大)	
	10.5 磁場応用	三井好古(鹿児島大)	
11 超伝導	11.1 基礎物性	堀井滋(京大), 加藤孝弘(矢崎総業)	
	11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	一野祐亮(名大)	
	11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用	小田部莊司(九工大)	
	11.4 アナログ応用および関連技術	山下太郎(名大)	
	11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	山梨裕希(横国大)	
12 有機分子・バイオエレクトロニクス	12.1 作製・構造制御	三崎雅裕(近大高専), 山本俊介(東北大), 帯刀陽子(農工大)	
	12.2 評価・基礎物性	田中啓文(九工大), 細貝拓也(産総研)	
	12.3 機能材料・萌芽のデバイス	山雄健史(京都工織大), 永野修作(名大), 吉田浩之(阪大), 浅川直紀(群馬大), 野々口斐之(奈良先端大)	
	12.4 有機EL・トランジスタ	村田英幸(北陸先端大), 中茂樹(富山大), 永瀬隆(大阪府大), 飯野裕明(東工大), 深川弘彦(NHK)	
	12.5 有機太陽電池	沈 青(電通大), 宮寺哲彦(産総研), 但馬敬介(理研)	
	12.6 ナノバイオテクノロジー	林智広(東工大), 三浦篤志(北大)	
	12.7 医用工学・バイオチップ	宇野重康(立命館大), 竹原宏明(東大), 宮本浩一郎(東北大)	

2018年秋季講演会 プログラム編集委員リスト

大分類分科名	中分類分科名	委員(所属)
		下線は大分類分科代表又は合同セッション代表
13 半導体 ※2018年春より「13.6 Semiconductor English Session」が廃止となったことで、13.6以降の中分類分科名が変更となっております。	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	運沼隆(筑波大), 嵯峨幸一郎(ソニー), 森伸也(阪大)
	13.2 探索的材料物性・基礎物性	山口憲司(量研機構), 未益崇(筑波大)
	13.3 絶縁膜技術	手賀直樹(日立), 藤井章輔(東芝メロリ)
	13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	野口隆(琉球大), 角嶋邦之(東工大), 米谷玲皇(東大), 後藤正英(NHK), 曾根正人(東工大)
	13.5 デバイス/集積化技術	小林正治(東大), 入沢寿史(産総研), 齋藤真澄(東芝メロリ)
	13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	中岡俊裕(上智大), 井原章之(情通機構), 原田幸弘(神戸大), 眞田治樹(NTT物性研)
	13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	加藤正史(名工大), 塩島謙次(福井大), 牧山剛三(富士通研), 佐藤威友(北大)
	13.8 光物性・発光デバイス	館林潤(阪大), 七井靖(青学大), 深田晴己(金沢工大), 篠崎健二(産総研)
	13.9 化合物太陽電池	荒木秀明(長岡高専), 八木修平(埼玉大)
	15 結晶工学	15.1 バルク結晶成長
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶		阿部友紀(鳥取大), 田橋正浩(中部大)
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎		影山健生(QDレーザ), 荒井昌和(宮崎大)
15.4 III-V族窒化物結晶		片山章二(阪大), 高橋邦方(パナソニック), 大矢昌輝(豊田合成), 谷川智之(東北大), 村上尚(農工大)
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶		澤野憲太郎(東京都大)
15.6 IV族系化合物 (SiC)		矢野裕司(筑波大)
15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥		沓掛健太郎(名大), 小野敏昭(SUMCO), 仮屋崎弘昭(グローバルウェーハズ・ジャパン), 竹内正太郎(阪大)
16 非晶質・微結晶		16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス
	16.2 エナジーハーベスティング	花村克悟(東工大), 鈴木雄二(東大)
	16.3 シリコン系太陽電池	小出直城(シャープ), 寺川朗(パナソニック), 傍島靖(岐阜大), 宮島晋介(東工大), 新倉ちさと(物材機構)
17 ナノカーボン	17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	林賢二郎(富士通研), 野内亮(大阪府立大), 吹留博一(東北大), 長汐晃輔(東大), 前橋兼三(農工大), 神田晶申(筑波大), 藤井健志(富士電機), 根岸良太(阪大), 山田貴壽(産総研), 乗松航(名大)
	17.2 グラフェン	
	17.3 層状物質	

表2. 合同セッション Joint sessions

合同セッションK 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	薄膜・表面の6.3酸化物エレクトロニクス, 6.4薄膜新材料, および結晶工学15.2 II-VI族結晶および多元系結晶で企画した合同セッションです。	高橋竜太(東大), 木下健太郎(東理大), 西川博昭(近畿大), 土屋哲男(産総研), 阿部友紀(鳥取大), 田橋正浩(中部大), 川原村敏幸(高知工大)
合同セッションM 「フォノンエンジニアリング」	9.4熱電変換, 13.7ナノ構造・量子現象, 17ナノカーボンで企画した合同セッションです。	栗野祐二(慶大), 塩見淳一郎(東大), 野村政宏(東大), 馬場寿夫(JST), 山本貴博(東理大), 中村芳明(阪大)